11/04/2025 Χαιδελβέογη, Γεομανία Αστέοιος Καλογήοου ΑΕΜ : 15473

Εισαγωγή:

Για την πρώτη άσκηση, πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές προσομοιώσεις για την ενδογενή συγκέντρωση ηλεκτρονίων στο Si (πυρίτιο), συναρτήσει της θερμοκρασίας.

Για τη δεύτερη άσκηση, πραγματοποιήθηκε μία προσομοίωση για υλικό Si με προσμίξεις As (αρσενικού), συναρτήσει της θερμοκρασίας.

Για μεγαλύτεοη ευκολία και εξοικονόμηση χώοου θα δείξω τέσσερα συνολίκα διαγοάμματα.

1η Άσκηση:

Ποιν απο την υλοποιήση κάποιου πειοάματος η κλίμακα της θεομοκοασίας μετατοάπηκε σε Κ (Kelvin) άρα η καινούργια κλίμακα είναι :

$$23 [K] \le T [K] \le 1273 [K]$$

α) Από την εκφώνηση δίνονται $E_{\rm g}$ = 1.12 [eV], $n_{\rm i\,300K}$ = 10^{10} [cm $^{-3}$] όπως και η τιμή του $k=8.62*10^{-5}$ [eV/K].

Πολύ απλά χοησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, την καινούργια κλίμακα της θερμοκρασίας όπως και την Σχέση 1:

$$n_{\rm i} = n_{{\rm i}\;300{\rm K}} * \sqrt{\left(\frac{T}{300}\right)^3} * \exp\left[\left(\frac{-E_{\rm g}}{2k}\right) * \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{300}\right)\right]$$
 (1)

Μποφούμε εύκολα να υπολογίσουμε και να σχεδιάσουμε την ενδογενή συγκέντφωση ηλεκτφονίων για κάθε θεφμοκφασία. Επέλεξα για ταχύτεφους υπολογιστικούς χρόνους να χωρίσω τα "βήματα" της θεφμοκφασίας ανά 10 μονάδες Kelvin.

β) Από την εκφώνηση, τώρα μας δίνεται πως έχουμε μία έξτρα εξάρτηση, που αναφέρεται στην εξάρτηση του ενεργειακού χάσματος σε σχέση με τη θερμοκρασία.

Ο τύπος που μας δίνεται είναι η Σχέση 2:

$$E_{g}(T) = E_{g}(0) - \frac{aT^{2}}{T+b}$$
 (2)

όπου E_g (0) = 1.166 [eV] , α = 4.73 * $10^{\text{--4}}$ [eV] και b = 636 [K].

Με τον ίδιο τρόπο όπως και στο α) υπολογίζουμε τα n_i με την **Σχέση** 3, τα αποθηκεύουμε και αργότερα θα τα σχεδιάσουμε όλα μαζί. Η **Σχέση** 3 είνα απλά η **Σχέση** 1 με χρονοεξαρτόμενη E_g .

$$n_{\rm i} = n_{\rm i \; 300K} * \sqrt{\left(\frac{T}{300}\right)^3} * \exp\left[\left(\frac{-E_{\rm g}({
m T})}{2k}\right) * \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{300}\right)\right]$$
 (3)

γ) Κρατώντας όλα τα υπόλοιπα από πριν, τώρα θα έχουμε και την θερμοκρασιακή εξάρτηση των N_C και N_V (N_C , $N_V \propto T^{3/2}$).

Οπότε τώρα με αυτήν την καινούργια πληροφορία ξανά - υπολογίζουμε το n_i χρησιμοποιώντας την **Σχέση** 4

$$n_{\rm i} = \sqrt{N_{\rm C} * N_{\rm V}} * \exp\left(\frac{-E_{\rm g}(T)}{2kT}\right) \tag{4}$$

όπου:

 $N_C = N_C (300K) * (T/300)^{3/2} \mu \varepsilon N_C (300K) = 2.8 * 10^{19} [cm^{-3}]$

 $N_{\rm V} = N_{\rm V} \ (300 K) * (T/300)^{3/2} \ \mu\epsilon \ N_{\rm V} \ (300 K) = 1 * 10^{19} \ [cm^{-3}]$

και φυσικά έχουμε το χρονοεξαρτόμενο $E_{g}\left(T\right)$ από την Σχέση 2.

Αντιστοίχως με τα υπόλοιπα υποερωτήματα, υπολογιζουμε τα n_i τα αποθηκεύουμε και τα σχεδιάζουμε όλα μαζί στο κάτω γράφημα:

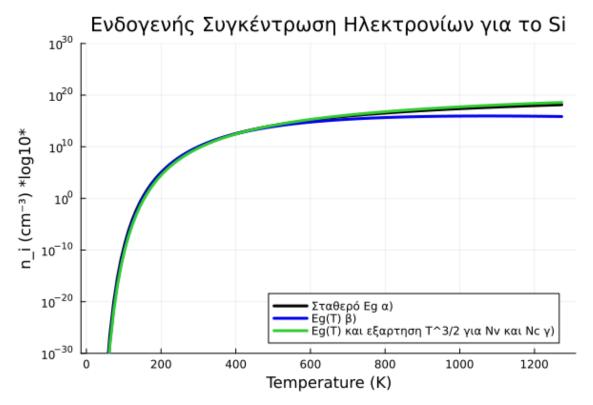


Figure 1: Ενδογενής Συγκέντρωση Ηλεκτρονίων και για τα τρία υποερωτήματα.

2η Άσκηση:

Σε αυτήν την άσκηση έχουμε ποοσμίξεις και εξετάζουμε το φαινόμενο "παγώματος των φορέων".

Τα δεδομένα που μας δίνονται σε αυτήν την άσκηση (φυσικά ισχύουν και τα προηγούμενα δεδομένα οπότε δεν τα ξανά αναφέρω) είναι:

Ποοσμίξεις αρσενικού (As) συγκέντρωσης N_d = 10^{16} [cm $^{-3}$], E_d = E_{C_s} - 0.054 [eV] δηλαδή 0.054 [eV] από το ελάχιστο όριο της ζώνης αγωγιμότητας του πυριτίου.

Με αυτά τα καινούργια δεδομένα και την Σχέση 5,

$$n_{\rm d} = N_{\rm d} \frac{1}{1 + 2e^{\frac{E_{\rm F} - E_{\rm d}}{k*T}}} \tag{5}$$

που επίσης μας δίνεται υπολογίζουμε την συγκέντοωση ηλεκτοονίων λόγω ποοσμίξεων.

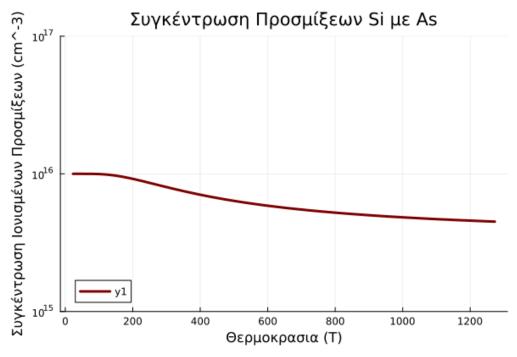
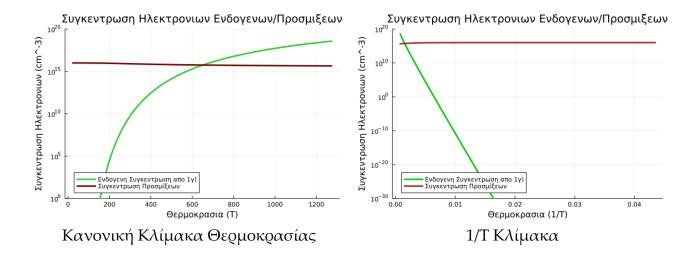


Figure 2: Συγκέντρωση Ποοσμίξεων Si με As.

Τέλος όπως ζητήθηκε και στην 2^{η} Άσκηση, σχεδιάζουμε στο ίδιο σχήμα (και με δύο διαφορετικές θερμοκρασιακές κλίμακες) τον συνδιασμό, της καλύτερης προσέγγισης της συγκέντρωσης των ενδογενών ηλεκτρονίων με την συγκέντρωση των ηλεκτρονίων λόγω προσμίξεων.



Σημείωση:

(Το αποτέλεσμα για την 2η άσκηση δεν μου φαίνεται σωστό παρόλα αυ'τα καθώς δεν καταλαβαίνω το λάθος μου σας στέλνω όλη την δουλεία μου.)

Για την ολοκληρωση του πρωτου σετ ασκησεων στο μαθημα χρησιμοποιηθηκε η γλωσσα προγραμματισμου Julia οπου και εγιναν οι αναγκαιοι υπολογισμοι και γραφηματα.Το IDE που χρησιμοποιηθηκε ειναι το VSCode και η γραφη της εργασιας γινεται παλι μεσα απο το VSCode χρησιμοποιωντας την Typst εφαρμογη (αντιστοιχη της LaTeX)